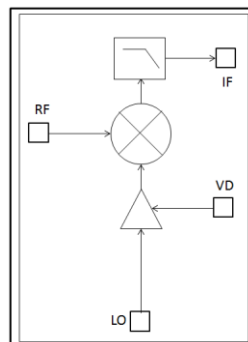




主要特点

射频频率：12 - 18GHz
中频带宽：DC - 4GHz
下变频转换损耗：8.5 dB
上变频转换损耗：7.0 dB
LO/Rf 隔离：25 dB
输入 P1dB：+13 dBm
功耗：65mA@+5V
芯片尺寸：2.5 × 1.2 × 0.1 mm³

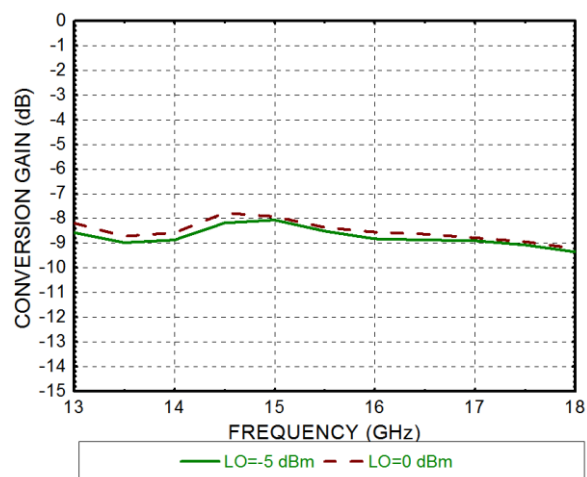
功能框图



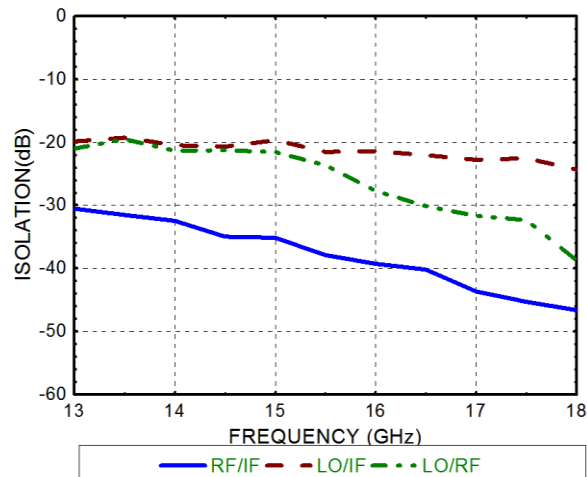
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $IF = 1\text{ GHz}$, $LO = -5\text{ dBm}$)

参数	最 小	典 型	最 大	单 位
射频频率 (RF/LO)	12 - 18			GHz
中频频率 (IF)	DC - 4			GHz
下变频转换损耗		8.5		dB
上变频转换损耗		7.0		dB
隔离度 “LO 至 RF”		25		dB
隔离度 “LO 至 IF”		25		dB
隔离度 “RF 至 IF”		35		dB
线性状态下 IF 端口对 RF 信号隔离度	35	45		dB
输入功率 1dB 压缩点		13		dBm
工作电流		65		mA

下变频转换增益 vs. 本振驱动

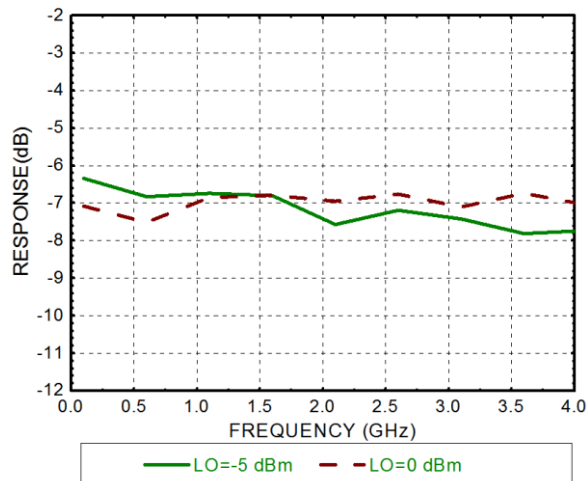


隔离度

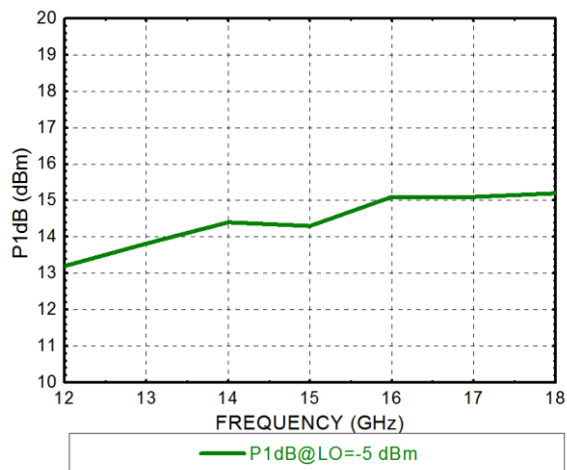




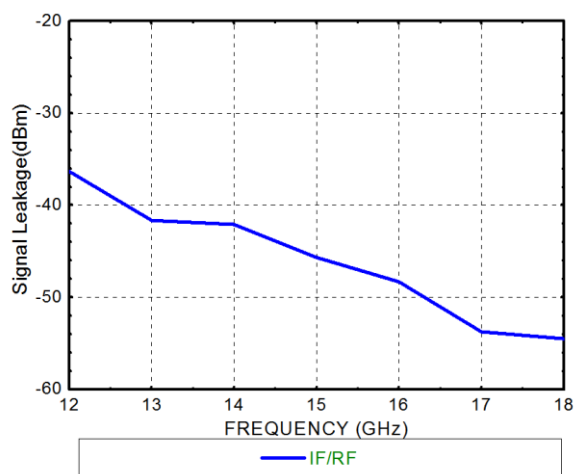
上变频转换增益 vs. 本振驱动



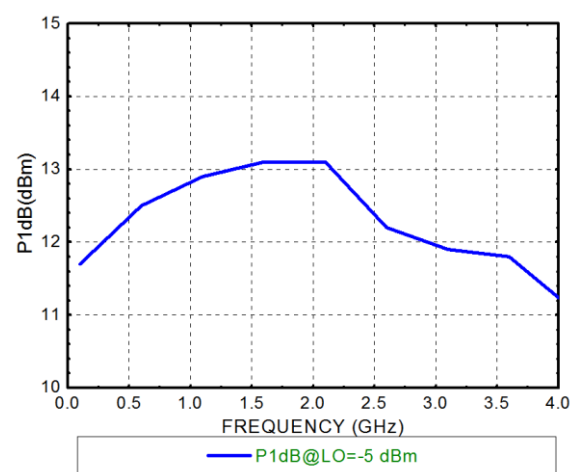
输入P1dB(下变频)



IF端口对RF信号隔离度

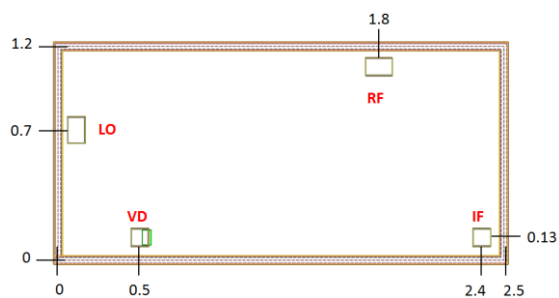


输入P1dB(上变频)



物理参数

单位: 毫米



杂散抑制

-	nLO				
mIF	0	1	2	3	4
0	XX	8	0	32	XX
1	16	0	35	20	16
2	54	44	37	64	54
3	65	54	60	71	65
4	70	73	61	75	70

IF=1GHz@-10dBm
LO=12.5GHz@-5dBm
All Values in dBc below the IF power level.

焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF	该焊盘是 DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2	LO	该焊盘是 RF 耦合, 并匹配至 50 Ohm
3	IF	该焊盘是 DC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
4	VD	电源电压, +5V
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

极限参数

射频/本振/中频输入功率: +15 dBm

储存温度: -65~+150°C

电源电压: +6 V

工作温度: -55~+85°C